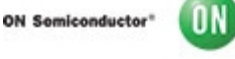












|  |   |
|--|---|
|   | <h2 style="color: red;">FQD13N10TM</h2>   |
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD13N10TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD13N10TM.pdf</a><br/><a href="#">2.FQD13N10TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45411 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|   |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>   |   |

### Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                                     | FQD13N10TM                                       |
| Hersteller                                      | Fairchild/ON Semiconductor                       |
| Beschreibung                                    | MOSFET N-CH 100V 10A DPAK                        |
| Kategorie                                       | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                      | 45411 pcs Stock                                  |
| Serie   | QFET®  |
| Technologie                                     | MOSFET (Metal Oxide)                             |
| Betriebstemperatur                              | -55°C ~ 150°C (TJ)                               |
| Befestigungsart                                 | Surface Mount                                    |
| Verpackung / Gehäuse                            | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63            |
| Supplier Device-Gehäuse                         | D-Pak  |
| Verlustleistung (max)                           | 2.5W (Ta), 40W (Tc)                              |
| Typ FET   | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                     | -  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                    | 100V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 10A (Tc)   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                          | 180 mOhm @ 5A, 10V                               |
| VGS (th) (Max) @ Id                             | 4V @ 250µA                                       |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                    | 16nC @ 10V                                       |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds             | 450pF @ 25V                                      |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)       | 10V  |
| Vgs (Max)                                       | ±25V   |
| Verpackung                                      | Tape & Reel (TR)                                 |

FQD13N10TM ist neu im Original, Suche FQD13N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD13N10TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD13N10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br><b>FQD14N15</b><br>FAI<br>FQD14N15 FAI                                       | <br><b>FQD14N15TM</b><br>Fairchild/ON Semiconductor<br>MOSFET N-CH 150V 10A DPAK                    | <br><b>FQD14N15TM</b><br>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>MOSFET N-CH 150V 10A DPAK | <br><b>FQD13N10TF</b><br>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>MOSFET N-CH 100V 10A DPAK |
| <br><b>FQD13N10TF</b><br>Fairchild/ON Semiconductor<br>MOSFET N-CH 100V 10A DPAK | <br><b>FQD13N10LTM_NBEL001</b><br>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>MOSFET N-CH 100V 10A DPAK | <br><b>FQD13N10LTM_NBEL001</b><br>Fairchild/ON Semiconductor<br>MOSFET N-CH 100V 10A DPAK  | <br><b>FQD15N05</b><br>FAIRCHILD<br>FAIRCHILD SOT-252                                      |

### heiße Teile

Mehr

|               |                |                |                  |                  |
|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| ⊗ FQD12N20TM  | ↔ FQD12N20TM   | ⇒ FQD12P10     | D FQD12P10TF     | ⇒ FQD12P10TF     |
| ⊣ FQD12P10TM  | ⊗ FQD12P10TM   | D FQD13N06     | ⇒ FQD13N06L      | ⇒ FQD13N06LTF    |
| ⊗ FQD13N06LTF | ⊣ FQD13N06LTM  | ⊗ FQD13N06LTM  | ↔ FQD13N06LTM-NL | ⇒ FQD13N06TF     |
| D FQD13N06TF  | ⊗ FQD13N06TM   | ⊣ FQD13N06TM   | ⊗ FQD13N10       | ⇒ FQD13N10L      |
| ⇒ FQD13N10LTF | ↔ FQD13N10LTF  | ⊗ FQD13N10LTM  | ⊣ FQD13N10LTM    | ⇒ FQD13N10LTM-NL |
| ↔ FQD13N10TM  | ⇒ FQD13N20D    | D FQD14N15     | ⊗ FQD16N15       | ⊣ FQD16N25C      |
| ⊗ FQD16N25CTM | D FQD16N25CTM  | ⇒ FQD16N25L    | ↔ FQD17N08       | ⇒ FQD17N08L      |
| ⊣ FQD17N08LTF | ⊗ FQD17N08LTF  | ↔ FQD17N08LTM  | ⇒ FQD17N08LTM    | ⇒ FQD17N10       |
| ⊗ FQD17P06    | ⊣ FQD17P06TF   | ⊗ FQD17P06TF   | D FQD17P06TM     | ⇒ FQD17P06TM     |
| ↔ FQD18N20V2  | ⊗ FQD18N20V2TM | ⊣ FQD18N20V2TM | ⊗ FQD19N10       | ⇒ FQD19N10L      |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited